محله علمی بژوشی «علوم وفناوری کی پدافند غیرعامل»

سال چهارم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲؛ ص ۱۹۸–۱۹۳

سنتز و مشخصه یابی نیمه هادی نانو ذرات سولفید سرب با روش اپتیکی

پرویز بروجردیان'*، سیده اکرم میرهای

۱– استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۲– کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (دریافت: ۹۱/۱۲/۰۷. پذیرش: ۹۲/۰۹/۱۵)

چکیدہ

در این مقاله به سنتز و مشخصهیابی خصوصیات نانوساختاری یکی از نیمه هادیهای مهم حسگری که در موضوع آشکارسازی، تشخیص و شناسایی کارایی بالایی دارد، پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از روش شیمی تر و به کارگیری یک عامل مهارکننده (۲- مرکاپتواتانول)، نانوذرات سولفید سرب سنتز گردید. بررسی خواصی از قبیل ساختار بلوری، اپتیکی، مورفولوژی (شکل) و اندازه نانو ذرات سولفید سرب توسط پراش اشعه X، اسپکتروسکوپی جذب مرئی- فرابنفش و میکروسکوپ تونلی پویشی انجام گرفت. با اسپکتروسکوپی جذب، قلههای اگزایتونی مربوط به نانوذرات سولفید سرب با کوچکتر شدن کلاسترها، بهوضوح مشاهده شد. عامل مهارکننده مرکاپتواتانول مورد استفاده، باعث مهار اندازه کلاستر شد و با افزایش غلظت آن میزان زیادی شیفت (جابهجایی) آبی در قلهها ظاهر گردید. پراش اشعه X قلههای مشخصه سولفید سرب و خلوص بالای نانو ذرات را تأیید و اندازه ذرات توسط رابطه شرر محاسبه شد. همچنین براساس تصاویرمیکروسکوپ الکترونی پویشی، ذرات ۴ تا ۵ نانومتری با تک پاشندگی بالا و مورفولوژی تقریباً کروی مشاهده گردید. نوآوری در این کار دستیابی به نانو ذرات RD با گاف انرژی در حدود ۴/۱۰ می با که تانون ذرات را تأیند و اندازه درات توسط رابطه شر محاسبه شد. همچنین براساس تصاویرمیکروسکوپ الکترونی پویشی، ذرات ۴ تا ۵ نانومتری با تک پاشندگی بالا و مورفولوژی تقریباً کروی مشاهده گردید. نوآوری در این کار دستیابی به نانو ذرات را تأیش مرای می انرژی در حدود ۴/۱۰ می باشد که تاکنون در سایر مقالات گزارش نشده است.

كليد واژهها: سولفيد سرب، مركاپتواتانول، گاف انرژی.

Synthesis and Characterization of Lead Sulfide Nanocrystallites Semiconductor via Optical Route

P. Boroojerdian*, S. A. Mirehi Malek Ashtar University of Technology (Received: 25/02/2013; Accepted: 06/12/2013)

Abstract

In this study, the synthesis and Nanocrystallites properties of one of the main semiconductors has been investigated which has high efficiency in detection, recognition and identification. Thus, PbS Nanocrystallites have been synthesized through wet chemistry using a capping agent (2-mercaptoethanol). Some properties including crystal, optic and morphology structure and the size of PbS Nanoparticles has been investigated through X-Ray diffraction, UV-VIS spectroscopy and STM (Scanning Tunneling Microscopy). The excitonic shoulders of PbS Nanoparticles become visible by clusters' shrinkage through VIS spectroscopy. 2-mercaptoethanol capping agent leads to handling of cluster size, and the increase of its concentration leads to much shifts in the shoulders. X-Ray diffraction approved the certain shoulders of PbS and the high purity of Nanoparticles, and the size of particles was calculated by Scherrer equation. Furthermore, based on STM, 4-5 nm Nanoparticles with energy gap of around 4.1 eV which has not been reported in other papers so far.

Keywords : PbS, 2-mercaptoethanol, Energy Gap.

۱. مقدمه

واژه یدافند غیرعامل به کلیه تدابیر، عملیات و روشهای مختلف که موجب جلوگیری و کاهش از خسارات در ابعاد متفاوتی می شود، اطلاق می گردد. جهت انجام و اجرای این امر در ابعاد سخت افزاری، نياز اوليه به آشكارسازي'، تشخيص و شناسايي الهداف وجود دارد. جهت نیل به آشکارسازی، تشخیص و شناسایی (DRI) در بازههای مختلف طیف الکترومغناطیسی، از انواع حسگرهای مختلف استفاده می شود. یکی از پنجرههای مهم طیف الکترومغناطیسی که از آن بهعنوان ینجره نظامی نیز یاد می گردد، در محدوده ۳–۱ (μm) می باشد. مهم ترین حسگر مورد استفاده که از دیر باز مورد توجه در توسعه و تحقیق (R,D) بوده است، سولفید سرب (PbS) میباشد. با ظهور نانوفناوری در چنـد دهـه اخیـر و پدیـدار شـدن افـقهـای امیدبخش در تغییر و بهبود خواص ذاتی مواد، ساخت حسگرهای کاراتر نسبت به همتایان قبلی فراهم شده است. یکی از نیمه هادیهای مهم در ساخت حسگرهای ۲-۱ (µm)، سولفید سرب است. در چند دهه اخیر، نانوبلورهای نیمه هادی یا نقاط کوانتمی (QD) توجه فراوانی را به خود جلب نموده است [۳–۱]. در ادامه تحقیقات اولیه بروس و افروس [۴ و ۵]، نقاط کوانتمی فراوانی از مواد گروه V-III، IV-VI ، II-VI تولید و بهدنبال آن پیشرفتهای شگرفی در حوزه های سنتز، مشخصهیابی ساختاری، خواص الکترونیکی و اپتیکی و ترمودینامیک نقاط کوانتمی نیمه هادیها بهوقـوع پیوسـت. در ایـن فرآيند، محققين براي نانوذرات نيمه هاديها ارتقاي خواص غیرخطی را که ناشی از اثر حبس کوانتمی است، پیش بینے کردند [۶ و ۷]. هنگامی که یک ذره از قبیل الکترون در یک حجم در فضایی محبوس می گردد، انرژی جنبشی (انرژی حبس نامیده می شود) کسب نموده و طیف انرژی آن گسسته می گردد. در یک نیمه هادی حجیم (بالک)، الکترونهای رسانش آزادانه در سراسر ماده حرکت میکنند در نتیجه، طیف انرژی آنها تقریبا ممتد و چگالی حالتهای مجاز الکترون برحسب انرژی واحد با مربع ریشه انرژی افزایش مییابد. اما در صورتی که ذرات نیمه هادی سنتز شده در حد فوق ریز باشند، الکترون در شرایط حبسشدگی قرار می گیرد، طیف انرژی ممتد به حالت گسسته درمی آید و در نتیجه گاف انرژی افزایش خواهد یافت. مقیاسی که در آن الکترون احساس حبس شدگی میکند، میبایست با شعاع بوهر حالت مقید (bound state) يك الكترون و حفره قابل مقايسه باشد. چنين جفتي از الكترون- حفره (اگزایتون نامیده می شود) كه قابل قیاس با اتم هيدروژن ميباشد، ميتواند پايين ترين حالت الكتروني تحريكشده حالت حجیم جامد تصور گردد. سولفید سرب (PbS) یک نیمه هادی گاف باریک نوع مستقیم از گروه IV-VI است که می تواند

در ادوات الكترودرخشایی ً از قبیـل دیودهـای LED و سـوییچهـای ایتیکی و لیزر کاربرد داشته باشد [۸]. همچنین PbS بهدلیل بـزرگ بودن شعاع اگزایتونی بوهر(۱۸nm) ناشی از کوچک بودن جرم مـؤثر حامل (m* =•/1mc) و ثابت دى الكتريك ايتيكي بزرگ، (٤=١٧) یک نیمه هادی مطلوب جهت تولید نقاط کوانتمی محسوب می گردد [۹]. متعاقباً، حالت حبس کوانتمی به سهولت حاصل شده و لبه جذب حالت زمین آن می تواند در یک بازه وسیع طول موجی (از مرئی تا مادون قرمز نزدیک) تنظیم پذیر باشد زیرا گاف انرژی در نقاط کوانتمی متناسب با R² میباشد. علاوه بر آن، بهدلیل کوچک بودن نسبت سطح به حجم، حالتهای سطح در مقایسه با نانو بلورهای نیمه هادی گروه II-VI نقش کوچکی در نقاط کوانتمی PbS ایفا می کنند. به علت حبس کوانتمی حامل های بار درون نانو ذرات PbS که منجر به شیفت آبی گاف اپتیکی و ظهور سطوح اگزایتونی می گردد، مورد علاقه فراوانی واقع شده است. سنتز PbS بهوسیله روشهای مختلفی از قبیل هدروترمال°، سالوترمال ً و سونوشیمی^۲ گزارش شدہ است که همگی زمان بر، غیراقتصادی، نيازمند به تجهيزات خاص سنتز و اغلب داراي عدم يكنواختي و تکپاشندگی در اندازه نانوذرات سنتز شده میاشند. در تحقیق حاضر از یک روش ساده شیمی تر با به کارگیری ماده مهارکننده مركاپتواتانول با فرمول شيميايي (HSCH₂CH₂OH) جهت سنتز استفاده شد. این روش دارای محاسن فراوانی از جمله، سادگی سنتز، اقتصادی بودن، در دسترس بودن مواد اولیه، عدم نیاز به تجهیزات پیچیده، کنترل فوقالعاده بر رشد ذرات و محصول فوق ریز با تک پاشندگی مطلوب میباشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عامل مهارکننده در کاهش اندازه ذرات میباشـد. بـرای ســنتز ذرات PbS، یونهای +Pb² و ^{-S} با یکدیگر واکنش نموده و مولکولهای PbS تشکیل می گردند. اما بهدلیل این که پیوندهای بین آنها از نوع یونی می باشد، کلاسترهای کوچک تشکیل نمی شوند، بلکه در اثر رشد به صورت تودهای در کنار یکدیگر قرار گرفته و در نهایت ساختار بلوری بالک در ابعاد میکرونی را تشکیل میدهند. در حالت بالک، وقوع و مشاهده خواص حبس کوانتمی بهدلیل اندازه بزرگ امکان پذیر نمی باشد. برای رسیدن به ذراتی در ابعاد نانومتری و کوچکتر از شعاع اگزایتونی بوهر، تلاشهایی از سوی محققین مختلف صورت پذیرفته است که تعدادی از آنها بیان می گردند. زیانگ و همکارانش در سال ۲۰۰۰ سنتز بلورهای سولفید سرب را با استفاده از واکنش یک محلول آبی قلیایی سولفور (S) و محلول آیی (Pb(CH₃COO).3H₂O) با یک فاز مکعبی را در دمای یایین تحت فشار اتمسفر انجام دادند. محصول نهایی بعد از جداسازی به کمک فیلتر، با اسید نیتریک ۰/۱ مولار و آب مقطر شسته شد و رسوب حاصل سیاه در خلأ در C[°] ۵۰ برای ۴ ساعت خشک شد.

- ⁷ Hydrotermal
- ⁸ Solvothermal

- ¹ Detection
- ² Recognition

⁴Electroluminescence

⁹ Sonochemistry

³ Identification

نتایج آزمایش نشان میدهد که کنترل مناسبی بر روند رشد نانو ذرات PbS وجود نداشته و کلاسترهای کوچکتر از شعاع بوهر سنتز نشده است [10]. در سال ۲۰۰۳ نیز نانوذرات PbS بهروش کلوئیدی با استفاده از عامل پوششی که شامل دو محلول از سـیلکا ٔ و تیتانیا^۲ سنتز شد. قله در طیف جـذبی در حـدود ۱۲۰۰ m قـرار داشت (در محدوده Near-IR می باشد) و گاف انرژی آن ۱/۰۳ محاسبه گردید. با این شرایط بهنظر نمی سد که نانو ذرات PbS با اندازهای کوچکتر از شعاع بوهر سنتز شده باشد [۱۱]. باکیوا و همکارانش در سال ۲۰۰۴ سنتز نانوکریستالهای PbS تکسایز را در محیط آبی گزارش کردند که دو عامل پوششی استفاده شدند و در آن، اسپکتروسکوپی فوتو و الکترودرخشانی در محدوده Near-IR (محدوده طيفی ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ نانومتر) انجام گردید. از نتایج آن بەنظر نمىرسد كە ھىچ يك از اين عوامل پوششى كنترل مطلوبى بر روند رشد نانو ذرات PbS داشته و نانو ذراتی کوچکتر از شعاع بوهر تولید شده باشد [۱۲]. تحقیق دیگر در سال ۲۰۰۸ برای سنتز نانوکریستال های سولفید سرب کروی با سورفکتنت (polyvinyl alchol) بهوسیله پرتودهی با باریکه الکترون گزارش شده است. بعد از تابش، رسوبهای جامد سیاه تولید گردید که پس از چندین مرتبه شستشو، در دمای C [°]۲۰ در خلأ برای ۶ ساعت خشک شد. در یک فرایند بهنسبت طولانی از سورفکتنت و پرتودهی الکترونی برای کنترل اندازه ذرات PbS استفاده شده است که بهنظر روشی پیچیده میرسد. در نتایج طیف جذبی، قله اگزایتونی ضعیفی در nm ۲۸۰ مشاهده گردید [۱۳]. در مراجع مختلف از عوامل پوششی متعددی برای جلوگیری از تودهای شدن نانو ذرات PbS استفاده گردید. اما هیچ یک موفق به تولید نانو ذرات PbS تک اندازه با پاشندگی مناسب با شعاعی کوچکتر از شعاع بوهر نشدند.

هدف از تحقیق حاضر، سنتز نانو ذرات PbS با روشی ساده، اقتصادی، بیخطر و در مدت زمانی کوتاه با استفاده از عامل مهار کنندهای می باشد. این عامل می بایست ضمن احاطه مطلوب بر روند گسترش اندازه نانو ذرات PbS و نانو ذرات PbS تک پاشنده را با ابعادی کوچکتر از شعاع بوهر تولید کند.

۲. بخش تجربی

مواد شیمیایی مورد استفاده شامل استات سرب^۲، سولفید آمونیوم[†] آمونیوم[†] و مرکاپتواتانول با حداقل خلوص ۹۹٪ از شرکت مرک آلمان میباشد و بدون هیچ خالصسازی مجدد استفاده گردید. تمام مراحل فرآیند واکنش در دمای اتاق با شرایط یکسان انجام و از آب دیونیزه در واکنشها استفاده گردید. ابتدا از هر یک از سه ماده فوق حجم ۵۰ میلیلیتر با مولاریته ۰/۱ بهصورت جداگانه تهیه شد. طروف شیشهای قبل از استفاده، با روشهای استاندارد آلودگی دایی، چند مرتبه شستشو و سپس خشک شدند. از یک بالن

شیشهای سه دهانه با حجم ۵۰۰ میلیلیتر جهت انجام فرایند واكنش استفاده شد. استفاده از گاز نیتروژن در تمام مدت انجام آزمایش جهت جلوگیری از اکسید شدن محصول اولیه و نهایی استفاده شد. ابتدا محلول استات سرب از قبل آماده، درون بالن سهدهانه قرار داده شد و سپس محلول مرکاپتواتانول که قـبلاً درون فنل شیشهای قرار داده شده بود، بهصورت قطرهای در فواصل ۵-۴ ثانیه به آن اضافه گردید. جهت مخلوط شدن منظم از همزن و سوزن مغناطیسی با دور کاری حدود ۱۰۰ rpm استفاده گردید. مطابق شکل (۱) دو دهانه دیگر بالن جهت ورود و خروج گاز نیتروژن به کار گرفته شد و خروجی آن درون محلول اسید سولفوریک قرار داده شد. قبل از شروع هر واکنش جریان گاز نيتروژن جهت شستشو و خروج اكسيژن از محيط واكنش برقرار شد. سپس محلول از قبل آماده شده سولفید آمونیوم به ترتیبی که در بالا بیان شد، به صورت قطرهای با فاصله زمانی ۵-۴ ثانیه به محلول قبلي اضافه گرديـد. در فراينـد واكـنش، چنـدين نكتـه از قبیل شدت به هم زدن محلول، فواصل زمانی افزودن قطرات به محلول و غلظت عامل مهارکننده تأثیر گذار تشخیص داده شد. آزمایشهای بعدی که شامل تغییر مولاریته عامل مهارکننده بود نیز در شرایط کاملاً یکسان انجام شد. در نهایت جهت مشخصـهیـابی از دستگاه UV-VIS مدل CARY-100 (بازه طيفها VV-V۰۰nm)، XRD مدل۲۳۷۳ XPert با تابش CuKα (λ=١/۵۴Å) و STM و XRD زير لايه HOPG (جريان كار ٠/١ نانو آمپر و ولتاژ ٣/٢ ولت) استفاده شد.



شکل ۱. شمایی از چینش تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه

۳. نتایج و بحث

در شکل (۲) نمونه (الف) ابتدا طیف ذرات PbS بالک بدون وجود مرکاپتواتانول بررسی می شود. همان طور که در شکل دیده می شود، فقط یک پیک حدود nm ۲۵۰ دیده می شود که پیک مشخصه PbS است و هیچ پیک اگزایتونی دیگری دیده نمی شود. قله جذب اصلی در نمونه (ب) از شکل (۲) که از مرکاپتواتانول با مولاریته ۰/۱ سنتز شده، در حدود nm ۲۶۰ واقع شده است و قله اگزایتونی که به دلیل اثر حبس کوانتمی می باشد، به نسبت ضعیف و در طول موج حدود ۲۲۵nm

¹ Silica

² Titania

⁴ Lead Acetate

⁵ Ammonium Sulfide

در نمونه (ج) از شکل (۲) قلههای جذب اصلی و اگزایتونی به حدود ۲۵۰۸m و ۳۰۲۳ شیفت پیدا کردهاند که این شیفتها با مشهودتر شدن آنها همراه میباشد. با افزایش بیشتر عامل مهارکننده مرکاپتواتانول به ۱مولار، در نمونه (د) از شکل (۲) هر دو قلههای جذب اصلی و اگزایتونی تقریباً بدون تغییر در محل قبلی ولی با شدت کمتر دیده میشوند. بهنظر میرسد که ذرات به کمترین اندازه (مشابه حالت قبلی) اما با شدت کمتر ایجاد شدهاند که بیانگر حالت اشباع میباشد.

گاف انرژی نانوذرات PbS، با توجه به طیف جذبی شکل (۲) به دو صورت محاسبه شد. ابتدا با استفاده از رابطـه E_g=1240/λ مــرتـوان گاف انرژی را محاسبه نمود. با توجه به شکل (۲) و قرار دادن λ= ۳۰۲nm، (محـل قلـه اگزایتـونی) در آن گـاف انـرژی ۴/۱eV محاسبه گردید. طبق این رابطه هر چه اندازه ذرات کوچکتر شود، گاف انرژی بزرگتر میشود. روش دوم، استفاده از فرمول معروف تاوک (Tauc) برای بهدست آوردن گاف انرژی میباشد که به صورت نوشته میشود و α همان ضریب ($(\alpha h v)^n = c(h v - E_n)$ جــذب اســت، در ایــن رابطــه ضــریب جــذب α بــا رابطــه با فرض اینکه d قطر نانو ذرات و A جذب $\alpha = 2.303 \times \frac{A}{d}$ نانو ذرات بهدست آمده از طیف جذبی، محاسبه می شود. همچنین hv انرژی فوتون فرودی است که با توجه به به طول موجهای طیف جذبی در شکل (۲-ج) جایگذاری شده است. ضربب c سرعت نور و h ثابت پلانک میاشد، E_g هم گاف انرژی است. n =۲ برای گذارهای مستقیم مجاز یا گاف انرژی مستقیم و n = 1/۲ برای گذارهای غیرمستقیم مجاز یا انرژی غیرمستقیم میباشد. گاف انرژی نانو ذرات PbS (گاف انرژی مستقیم) با رسم منحنی مطابق شکل بەدست مىآيد. $(\alpha h v)^2 = c(h v - E_{\alpha})$ بەدست مىآيد.



شکل ۲. طیف فرابنفش - مرئی الف) ذرات بالـک PbS، ب) نـانوذرات PbS ســنتزشـده توسـط مرکاپتواتـانول بـا مولاریتـه ۰/۱۸، ج) مرکاپتواتـانول با مولاریته ۱۸۸۰ و د) مرکاپتواتانول با مولاریته ۱۸

همان طور که مشاهده می شود، نتایج حاصل از دو روش فوق، تقریباً با یکدیگر برابرند و گاف انرژی تقریباً ۴/۱eV برای نانوذرات PbS در این تحقیق بهدست آمد. جهت تأیید ساختار بلوری ماده و تعیین متوسط اندازه ذرات از پراش اشعه X استفاده گردید. نمونه سازی XRD بهروش استاندارد انجام و روبش از ^{*}۶۰ - ۲۰ = ۲ با سرعت ۲۰۲۲ انجام پذیرفت. در شکل (۴ – الف) طیف پراش اشعه Xمربوط به ذرات PbS بالک بدون وجود مرکاپتواتانول بررسی می شود و سپس در این شکل نانو ذرات PbS سنتز شده توسط مرکاپتواتانول با مولاریته به ترتیب ب) M (۰۰ هر) ۸ و د) M ۱ مطالعه می شود.



شکل۳. نمودار ⁽(۵*hv*) بر حسب *hv* برای نانو ذرات PbS

همان طور که در نمودار شکلهای بالا دیده می شود در نمونه با مولاریته ۰/۱ پهنای کامل در نصف ارتفاع (FWHM) قله بیشتر و شدت آن نسبتاً بیشتر است (باریکتر می باشد). وجود قلههای ظاهر شده در شکل در محدوده ^۰۶۰ – ۲۰۰ =۲۴ بیانگر مشخصههای اصلی صفحات PbS می باشد. با استفاده از رابطه شرر^۱، متوسط اندازه ذرات قابل محاسبه می باشد:

$$t = \frac{\delta r \mathcal{H}}{\beta \cos \theta_a} \tag{1}$$

که در این رابطه، t اندازهٔ ذره، β پهنای قله پراش در نصف ارتفاع بر حسب رادیان، λ طول موج اشعه X و $_{\theta}$ زاویه براگ است. همچنین متوسط اندازه ذرات از رابطه فوق حدود ۵۳۳ محاسبه گردید. شکل (۴) تفاوت این طیفها را بهطور واضح نشان میدهد. در واقع هر چه اندازه ذرات کوچکتر شود، قلهها پهنتر و ارتفاع آنها کاهش مییابد. در نمونه الف از این شکل طیف پراش اشعه Xمربوط به ذرات PbS بلک بدون وجود مرکاپتواتانول بررسی می شود که دارای پیکهای تیزی است که نشان دهنده پیکهای مشخصه PbS می باشد. طیف شماره (ب) مربوط به نانو ذرات Bla استز شده با غلظت ۱/۱ مولار مرکاپتواتانول می باشد که در آن قلههای نسبتاً تیزی دیده می شود. طیف شماره ج) مربوط به غلظت ۵/۱ مولار

0/02

مرکاپتواتانول میباشد که قلههای آن نسبت به نمونه قبلی پهـنتـر شده است. در نهایت طیف شـماره (د) مربـوط بـه غلظـت ۱مـولار مرکاپتواتانول است که ارتفاع قلهها کاهش بیشتری یافته اسـت کـه نشان دهنده کاهش اندازه ذرات میباشد و ساختار بلوری بـه سـمت ذرات بیشکل میل میکند. همچنین شکل (۵) میکروگراف تعدادی از ذرات را بـا کمـک STM نشـان مـیدهـد. همانطـور کـه از میکروگرافها دیده میشوند، ذرات کـروی و تـا حـدودی اگلـومره هستند. انـدازه ذرات در میکروگـرافها در حـدود m ۵-۴ دیـده میشوند که تقریب مطلوبی با محاسبه از رابطه شرر دارد. شکل (۵) بهخوبی تأثیر بهکارگیری عامل مهارکننـده مرکاپتواتـانول در رشـد ذرات PbS را نشان میدهد.



درات ۱۵۵ مستعرمیت کوشیت مرکپواتیون به مولاریت ۱۸۹۰ . مرکاپتواتانول با مولاریته ۸۵۸ و د) مرکاپتواتانول با مولاریته ۱۸۸



شکل ۵. تصویر میکروسکوپ تونلزنی پویشی از نانوذرات PbS سنتز شـده توسط محلول ۰/۵ مولار مرکاپتواتانول

۴. نتیجهگیری

در مقاله حاضر به سنتز و مشخصه یابی خصوصیات نانوساختاری یکی از نیمه هادیهای مهم حسکری که در موضوع آشکارسازی، تشخیص و شناسایی در پدافند غیرعامل در راستای استتار، اختف و فريب، كارايي بالايي دارد پرداخته شد. در ايـن تحقيـق بـا افـزايش مولاريته مركايتواتانول، شدت قله اكزايتوني افزايش يافته و جابهجایی به سمت آبی ایجاد شده است. این میزان جابهجایی نشاندهنده کوچکتر شدن اندازه نانوذرات PbS به کمتر از شعاع اگزایتونی بوهر میباشد. میزان جابهجایی به سمت آبی و شدت قله افزایش چشمگیری داشته است. این مقدار شیفت در هیچ یک از مقالات تجربی مشاهده نشده است، اما براساس مقالات تئوری این میزان شیفت توجیه پذیر می باشد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که ذرات سنتز شده توسط مرکاپتواتانول دارای ابعاد فوق ویژه و تکپاشندگی بالایی میاشند و این یکی از برتریهای مر کاپتواتانول نسبت به سایر عوامل مهار کننده مورد استفاده در سایر گزارشات میباشد. همچنین گاف انرژی نانو ذرات PbS در حدود eV ۴/۱ حاصل شده که نسبت به گاف انرژی ذرات بالک PbS، حدود ۱۰ برابر افزایش داشته است که در واقع نشان دهنده کاهش اندازه ذرات PbS است.

- [7] Minti, H.; Eyal, M.; Reisfeld, R.; Berkovic, G. "Quantum Dots of Cadmium Sulfide Thin Glass Films Prepared by Sol-Gel Technique"; Chem. Phys. Lett. 1991, 183, 277-282.
- [8] Gadenne, P.; Yagil, Y.; Deutscher, G. "Transmittance and Reflectance *in situ* Measurements of Semicontinuous Gold Films During Deposition"; J. Appl. Phys. 1989, 66, 3019-3025.
- [9] Borrelli, N. F.; Luong, J. C. "Semiconductor Microcrystals in Porous Glass"; Proc. SPIE. 1987, 866, 104.
- [10] Zhang, W.; Zhang, L.; Cheng, Y.; Hui, Z.; Zhang, X.; Xie, Y.; Qian, Y. "Synthesis of Nanocrystalline Lead Chalcogenides PbE (E=S, Se, or Te) from Alkaline Aqueous Solutions"; Mater. Res. Bull. 2000, 35, 2009-2015.
- [11] Capoen, B.; Martucci, A.; Turrell, S.; Bouazaoui, M. "Effect of sol-Gel Solution Host on the Chemical and Optical Properties of PbS Quantum Dots"; Molecular Structure 2003, 651, 467-473.
- [12] Bakueva, L.; Gorelikov, I.; Musikhin, S.; Sheng Zhao, X.; Sargent E.; Kumacheva, E. "PbS Quantum Dots with Stable Efficient in the Near-IR Spectral Range"; Advanced Materials 2004, 16, 926-929.
- [13] Wu, M.; Zhong, H.; Jiao, Z.; Li, Z.; Sun, Y.;. "Synthesis of PbS Nanocrystallites by Electron Beam Irradiation"; Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 2008, 313-314, 35.

- Gorer, S.; Hodes, G. "Quantum Size Effects in the Study of Chemical Solution Deposition Mechanisms of Semiconductor Films"; J. Phys. Chem. 1994, 98, 5338-5346.
- [2] Empedocles, S. A.; Bawendi, M. G. "Influence of Spectral Diffusion on the Line Shapes of Single CdSe Nanocrystallite Quantum Dots"; J. Phys. Chem. B 1999, 103, 1826-1830.
- [3] Ludolph, B.; Malik, M. A.; Brien, P. O.; Revaprasadu, N. "Novel Single Precursor Routes for the Direct Synthesis of Highly Monodispersed Quantum Dots of Cadmium or Zinc Sulfide or Selenide"; Chem. Commun. 1998, 17, 1849-1850.
- [4] Brus, L. E. "Electron-Electron and Electron-Hole Interactions in Small Semiconductor Crystallites: The Size Dependence of the Lowest Exited Electronic State"; J. Chem. Phys. 1984, 80, 4403-4407.
- [5] Efros, A. L.; "Interband Absorption of a Light in a Semiconductor Sphere"; Sov. Phys. Semicond. 1982, 16, 772-774.
- [6] Ricard, P. H.; D.; Flytzanis, C. H. R. "Quantum Confinement Mediated Enhancement of Optical Kerr Effect in CdS_xSe_{1-x} Semiconductor Microcrystallites"; Applied Physics B Photophysics and Laser Chem. 1990, 51, 437-442.